

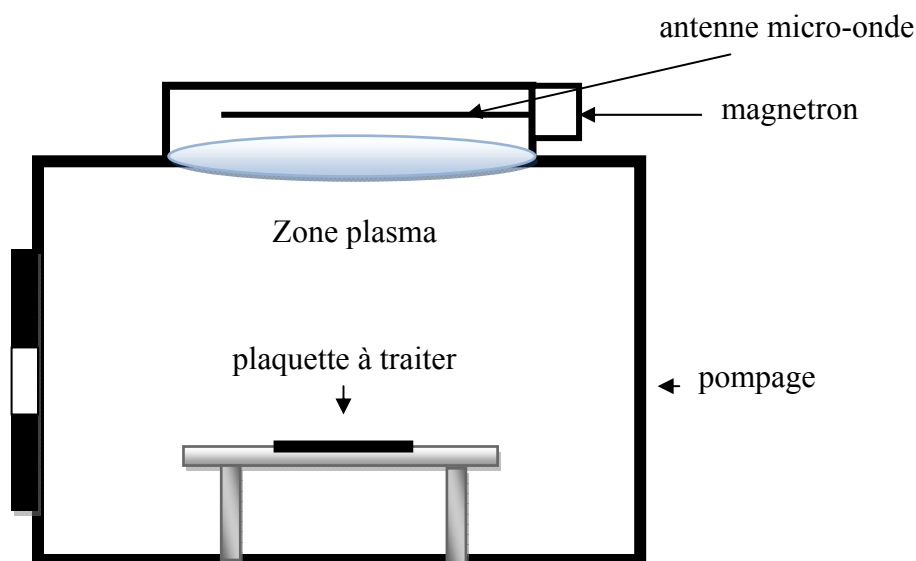
PLASMA DE DELAQUAGE ET DE TRAITEMENT DE SURFACE (DIENER NANO)

Cet équipement permet de réaliser par plasma continu, le délaquage de résines photosensibles en technologie MOS.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Source microonde 2.45GHz 1000W
- Température procédé 20°C à 200°C
- gaz : SF6, CF4, O2, N2.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Un gaz est introduit dans la chambre de gravure sous vide. Il est ionisé en un plasma réactif par l'intermédiaire d'un générateur radiofréquence qui excite un magnétron. Le plasma produit alors une attaque physico-chimique du matériau. Il en résulte des produits de réactions volatiles qui sont évacués par le système de pompage. L'équipement est équipé d'un système de détection de fin d'attaque. Les traitements des plaques peut se faire à pression contrôlée.

CONTACTS

Pascal Dubreuil : dubreuil@laas.fr

Djaffar Belharet : dbelhare@laas.fr

Laurent Jalabert : jalabert@iis.u-tokyo.ac.jp

ENGLISH VERSION→

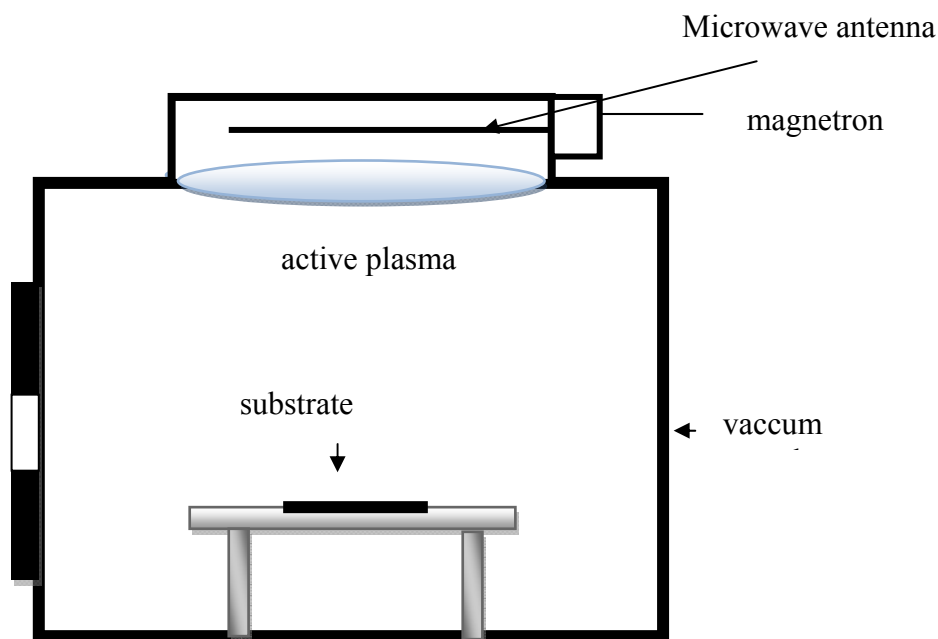
STRIPPING AND SURFACE ACTIVATION PLASMA (DIENER NANO)

This equipment enables continuous plasma etching for stripping of photoresists in MOS technology.

MAIN CHARACTERISTICS

- Micro-wave Source : 2.45GHz 1000W
- Process température 20°C à 200°C
- gas : SF6, CF4, O2, N2.

PRINCIPLE



A gas is introduced into the vacuum chamber. The gas is ionized in reactive plasma with the help of a radio frequency generator that excite a magnetron. Plasma then produces a physico-chemical attack of the material. As a result, volatile reactions products are extracted by pumping system. The equipment is equipped with an end point detection system. The wafers can be processed at controlled pressure.

CONTACTS

Pascal Dubreuil : dubreuil@laas.fr

Djaffar Belharet : dbelhare@laas.fr

Laurent Jalabert : jalabert@iis.u-tokyo.ac.jp